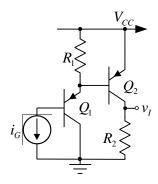
ODSEK ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ODSEK ZA SIGNALE I SISTEME ODSEK ZA FIZIČKU ELEKTRONIKU

1. [10] Parametri tranzistora u kolu sa slike 1 su: $\beta_F = 100$, $V_{EB} = V_{\gamma} = V_{EBS} = 0.6$ V, $V_{ECS} = 0.2$ V i $V_A \rightarrow \infty$, a poznate su i otpornosti $R_1 = 2$ k Ω , $R_2 = 1$ k Ω , kao i napon napajanja $V_{CC} = 3$ V. Ako se struja i_G menja u granicama $0 < i_G \le 5$ μ A, odrediti i nacrtati karakteristiku $v_I(i_G)$.



Slika 1

- 2. a) [3] Nacrtati kaskodni pojačavač sa NPN ulaznim tranzistorom i NMOS izlaznim tranzistorom.
 - b) [2] Izračunati naponsko pojačanje pojačavača iz a).
 - c) [1] Izračunati ulaznu otpornost pojačavača iz a).
 - d) [1] Izračunati izlaznu otpornost pojačavača iz tačke a).
 - e) [3] Nacrtati vremenske dijagrame napona na svim priključcima oba tranzistora pojačavača iz tačke a) za sinusoidalan napon pobudnog generatora.